



▲中國光芯片企業的技术突破與產業升級、本土供應鏈的不斷完善，有望逐步打破美國企業的壟斷，在全球光芯片領域佔據重要地位。

經濟觀察家

随着全球数字化轉型進入深水區，光芯片已成為中美兩國高科技競爭的全新焦點，兩國依託各自的產業基礎、政策導向與技術優勢，在光芯片產業鏈各環節展開全方位、多層次的博弈，這種競爭既倒逼雙方技術迭代，也深刻推動全球光芯片產業的升級與重構。

中美角逐光芯片領導地位



淵淵遠略
袁淵

AI算力爆發、數據中心規模擴張及6G技術迭代升級，推動光芯片從傳統光通信領域的「配角」，快速升級為數字基建的核心器件，其承擔的電信號與光信號高效轉換使命，直接決定全球數字經濟發展的效率上限，更成為衡量國家科技實力與產業競爭力的核心指標之一。

光芯片產業鏈清晰分為上游材料與設備、中游設計製造、下游光模塊及終端應用三大核心環節，整體呈現「上游壁壘高、中游分化大、下游需求旺」的鮮明特徵。其中，中游光芯片設計製造是產業鏈的核心樞紐，直接決定產品性能與附加值，也是中美兩國競爭的主戰場；上游材料與設備是產業發展的「卡脖子」環節，技術壁壘極高，直接決定一國光芯片產業的自主可控能力；下游光模塊及終端應用則是競爭的「需求落地」載體，直接體現產業競爭力的市場轉化能力與場景適配水平。

中國擁完整產業鏈配套

從全球競爭格局來看，當前光芯片行業已形成「中美雙雄引領、日韓歐補充」的穩定格局；美國憑藉在高端芯片、核心材料與生產設備領域的技術壟斷優勢，牢牢佔據全球高端市場主導地位，掌控行業技術迭代方向與核心話語權；中國依託完整的產業鏈配套體系、規模化製造優勢及國家政策強力支持，在中低端光芯片市場實現全面突破，同時逐步向高端市場滲透，市場份額持續提升；日本、歐洲則在襯底材料、高端設備等細分領域保持局部技術優勢，成為中美競爭格局中的重要制衡力量。

中美兩國作為全球光芯片產業的核心玩家，雙方的競爭不僅深刻重塑兩國自身的光芯片產業格局，更對全球光芯片的技術迭代、供應鏈布局、市場格局產生了深遠影響，整體呈現「競爭與協同並存、分化與融合共生」的發展態勢，這種影響將長期持續，推動全球光芯片產業進入全新的發展階段。

其一，推動全球光芯片技術迭代加速。中美兩國為鞏固自身競爭優勢，持續加大光芯片領域的研發投入，倒逼兩國企業加快核心技術突破，推動光芯片向高速化、集成化、低功耗、小型化方向快速升級。美國在高端芯片、前沿技術領域的領先優勢，與中國在規模化製造、應用場景落地方面的優勢形成互補，間接推動全球光芯片技術的商業化進程，為AI、6G、量子計算等前沿領域的發展提供了核心支撐。

其二，全球光芯片供應鏈呈現「多元化、區域化」重構。受中美競爭及全球供應鏈安全需求的影響，全球光芯片供應鏈打破了原有「全球化分工」的格局，逐步向區域化、多元

化方向轉型。美國推動光芯片製造、核心材料等環節向日韓等盟友轉移，試圖構建「脫離中國」的供應鏈體系；中國則加速培育本土供應鏈，推動上游材料、核心設備、中游芯片、下游光模塊企業協同發展，提升供應鏈自主可控能力，同時加強與東南亞、歐洲等地區的合作，拓展供應鏈多元化渠道，降低單一市場與單一供應商的依賴。

其三，全球光芯片市場格局呈現「兩極分化」加劇態勢。中美兩國憑藉各自的核心優勢，佔據全球光芯片市場的主導地位，形成「雙雄對峙」的市場格局，且這種格局將進一步強化。美國企業主導高端光芯片市場，聚焦高附加值產品，產品利潤率維持在高位，牢牢掌握高端市場的話語權；中國企業主導中低端光芯片市場，依託成本與規模優勢，佔據全球大部分市場份額，同時逐步向高端市場滲透，市場份額持續提升。

美技術封鎖 倒逼自主創新

其四，技術合作與技術封鎖並存，行業競爭複雜性提升。一方面，中美兩國在光芯片的基礎研究、前沿技術探索等領域仍存在少量合作，部分企業通過技術授權、聯合研發等方式實現優勢互補，共同推動全球光芯片技術的進步；另一方面，美國的技術封鎖逐步升級，不斷擴大出口管制範圍，禁止高端光芯片、核心設備向中國出口，限制中國企業參與國際合作與技術交流，加劇了全球光芯片產業的技術壁壘，也倒逼中國光芯片企業加快自主研發步伐。

面對美國的技術封鎖與激烈的市場競爭，中國光芯片產業要實現突圍，擺脫進口依賴，實現高質量發展，需立足自身優勢，聚焦核心短板，採取「技術攻堅、產業鏈協同、政策賦能、市場驅動」的綜合策略，循序漸進、久久為功，逐步縮小與美國企業的技術差距，構建自主可控的光芯片產業鏈，在全球競爭中佔據主動地位。

首先，聚焦核心短板，加大高端技術研發投入。在核心材料領域，加大磷化鎵（InP）、砷化鎵（GaAs）等高端襯底及外延材料的研發投入，支持雲南鎢業、三安光電、有研新材等龍頭企業擴大產能、提升生產良率，逐步實現高端襯底與外延材料的進口替代。在高端光芯片領域，支持源傑科技、仕佳光子、光庫科技等龍頭企業開展聯合研發，共享技術資源，提升產品良率與性能，縮短與美國企業的技術差距。

其次，強化產業鏈協同，完善本土供應鏈布局。推動光芯片產業鏈上中下游協同發展，構建自主可控、高效協同的本土供應鏈體系。上游材料、設備企業與中游芯片企業加強技術對接與產品適配，優化產品設計與生產流程，降低供應鏈成本，提升產業鏈協同效率；中游芯片企業與下游

光模塊企業深度綁定，實現「芯片—模塊」一體化發展，根據光模塊的需求優化芯片設計，提升產品適配性與附加值，同時依託下游光模塊的規模化需求，推動芯片量產，降低生產成本。

再次，依託政策賦能，借力資本市場支持。充分利用國家半導體產業扶持政策，為光芯片產業發展提供有力支撐。積極爭取國家專項資金、稅收減免、研發補貼等政策支持，緩解企業研發投入壓力，鼓勵企業加大光芯片領域的研發投入；出台專項政策，對高端光芯片、核心材料與設備的技術突破給予重點獎勵，引導企業聚焦核心短板，加快技術突破；完善行業標準與監管體系，規範行業發展，為光芯片產業營造公平、有序的市場環境。

最後，立足市場需求，推動技術商業化落地。依託國內龐大的市場需求，推動光芯片技術的商業化落地，實現「研發—量產—迭代」的良性循環。聚焦國內5G、數據中心、AI等核心應用場景，鞏固中低端光芯片的規模化優勢，提升市場份額，積累技術經驗與資金；針對高端市場，逐步推出適配800G、1.6T及以上光模塊的高端芯片產品，滿足國內高端場景的需求，逐步實現高端芯片的進口替代；積極拓展車載激光雷達、AR/VR、量子計算等新興應用場景，培育新的需求增長點，推動光芯片技術在新興領域的應用，提升產品附加值。

有望打破美企壟斷

光芯片作為數字基建的核心器件，是AI、6G、量子計算等前沿領域發展的基礎，已成為中美兩國高科技競爭的戰略制高點，兩國的博弈將長期持續，既給中國光芯片產業帶來了嚴峻的挑戰，也為產業升級提供了強大的動力。

展望未來，全球光芯片行業將持續向高速化、集成化、生態化方向發展，中美兩國的競爭將進一步聚焦前沿技術突破與供應鏈自主化，同時全球光芯片供應鏈的多元化、區域化趨勢將更加明顯。對中國而言，光芯片產業的破局之路任重道遠，需正視與美國企業的技術差距，不盲目跟風，立足自身優勢，聚焦核心短板，加大研發投入，強化產業鏈協同，借助政策與市場的雙重力量，加快國產替代步伐，推動產業高質量發展。

隨著中國光芯片企業的技术突破與產業升級、本土供應鏈的不斷完善，中國有望逐步打破美國企業的壟斷，在全球光芯片領域佔據重要地位。這不僅能保障國內數字基建的安全穩定，擺脫對進口光芯片、核心設備的依賴，更能推動全球光芯片技術的迭代與產業發展，為中國數字經濟高質量發展與科技自立自強提供核心支撐，也為全球數字經濟的發展注入新的動力。

（作者為外資投資基金董事總經理）

韓國股市的「芯片—原油」經濟賬



金融熱評
張濤

自2月28日以來，美國與以色列開始軍事打擊伊朗，全球市場波動性明顯上升，金融敘事發生巨大改變——在AI巨頭持續投資敘事下帶動芯片供不應求的基礎上，又增加了供給體系不穩定帶來的原油供給受阻。進入3月份之後，全球金融市場最主要的敘事線索已經變為：芯片+原油。

基於上述變化，近期受美以打擊伊朗衝擊影響最嚴重的地方應該就是當前市場的風口所在，目前看這個風口是韓國。以2月27日收市為基準，韓國綜合股指由歷史最高的6347.41最低跌至5059.45點，跌幅超過20%；韓國兌美元的匯率則貶破1500，至1506.85，貶值幅度接近6%；韓國10年期國債收益率由3.42%最高上行至3.80%，幅度接近40個基點，呈現出事件衝擊下流動性收緊的「股債匯」三殺。

不過，韓國股市依然是今年全球表現最好的市場。截至昨日收盤，韓國綜合指數今年的累計漲幅仍在30%以上，累計漲幅最高一度達48%，而科技含量更高的韓國KOSPI200的累計漲幅仍有37%以上，累計漲幅最高曾達54%，同期的納斯達克指數則累計下跌2.26%（納指自去年11月以來，已盤整了五個多月）。

韓美科技股表現迥異的背後，反映了AI敘事的變化——科技巨頭均不遺餘力增加投資，加速推動支撐AI的基礎設施建設、B端的研發投入和C端的營銷。結果就是，AI所需的硬件供應始終跟不上需求的增長，各類芯片價格持續上漲。韓國作為芯片重要輸出國，自然受益於此，而像韓國這樣受益於芯片輸出的地區股市今年表現都很好。

但與韓國類似，芯片輸出地對原油進口均有較高的依賴。3月以來，霍爾木茲海峽通行率大幅下降，以及未來可能陷入長期不穩定的因素，不僅大幅推升了原油價格，更令市場對原油價格回落普遍悲觀。2月28日至今，布油價

格多次站到100美元上方，而12月交割的期貨價格也在80美元以上。另據高盛最新預測顯示，在極端情景下，布油價格將至140美元。因此，當前擺在市場面前最大的不確定性，就是芯片輸出國能否扛住原油價格的飆升。

警惕流動性衝擊波

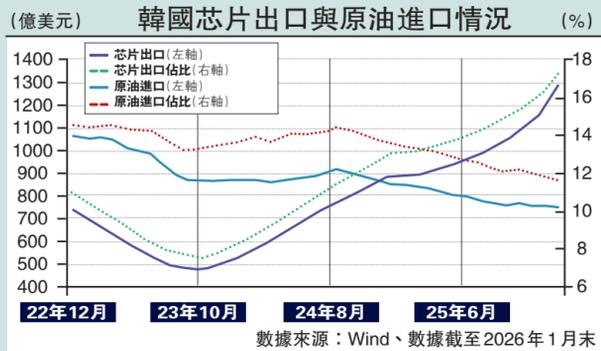
以韓國為例，得益於量價的共同貢獻，截至1月末，韓國芯片出口的年總額接近1300億美元，佔韓國出口總額的17.3%，而在2023年三季度，韓國芯片的出口額尚不足480億美元，出口佔比也僅為7.5%。

同期韓國原油進口的年總額為740億美元，原油進口的佔比為11.6%（2024年三季度，韓國原油年進口額為908億美元，進口佔比為14.4%）。原油進口額下降的主因是原油價格的下跌，2024年三季度韓國原油進口價格為90美元/桶，今年1月則降至67美元/桶，累計降幅26%，而其原油進口的規模始終穩定在單月1000萬至1200萬噸的水平（1噸=7桶）。

如果按照芯片出口1300億與原油進口740億美元的年化水平來估算（盈餘560億美元），過去一年間，韓國平均每月進口1140萬噸原油（約8000萬桶），盈餘的560億美元很快就會被油價上漲所耗盡，而一旦高油價的中長期預期形成，當前韓國資本市場敘事的「芯片+原油」邏輯就要發生方向性逆轉，對於不到3萬億美元市值的韓國股市，很難抵擋大額資金流的持續變化。

韓國股市作為對本輪新敘事定價最明顯的市場，對定價邏輯逆轉後的流動性衝擊一定也最敏感，在年報和一季報即將公布的當下（目前市場預期三星、海力士的財報盈利將很好），韓國股市的表現將更具信號意義，可將其作為全球金融市場的風向標。

（作者為中國建設銀行金融市場部分析師）（註：文中觀點與所屬單位無關）



供應賣少見少 港島新盤定價進取



樓語縱橫
楊永健

去年本港新盤市場異常熱鬧，整體銷售顯著回升，港島區成績與新界區並駕齊驅。以升幅計算，新界區新盤銷售按年大增53%，港島新盤升幅亦有50%，以至總體銷售金額，兩區漲幅均為三成，港島區成交690億元，比起新界區還要高。

2025年，港島區新盤市場呈「氣氛回暖、收租客增加、供應多元化」格局，細價盤與大戶型項目同步受捧，成交動力主要來自兩方面：投資氣氛好轉與發展商積極推售。港島區新盤銷售超越3500伙之多，錄得2004年以來最好成績。多個項目陸續登場，包括去年年初的北角皇都、再加上黃竹坑站上蓋的傲晨I及II、柴灣海德園，以至多個半山及灣仔區的單幢新盤，如半山The MVP、半山名匯、堅尼地道33號、灣仔Woodis、Spring Garden，再加上西半山的豪宅天御I及II，總括而言新盤多達十多個。

踏入2026年，港島區新盤仍然維持熱鬧。開局首幾日淺水灣豪宅

1 South Bay Close已率先以招標形式開盤，接着有堅尼地城海峽、黃竹坑DEEP WATER SOUTH6A、6B期，以至鴨洲的PROTO及環南亦已部署短期展開推售。換言之，今年首季已有五個新盤推售，相信全年仍有十多個項目登場。

明年落成量料跌穿2000伙

大家亦需留意，未來港島區新盤勢賣少見少，過去幾年供應重點是黃竹坑站上蓋，但已賣到最後一期。按差餉物業估價署的推算，去年港島新盤落成量達3100伙，今年落成量將減至2949伙，相信明年勢必進一步回落至不足2000伙。

近期港島區新盤大多已轉為以招標形式推售，未來供應賣少見少，新盤定價自然相對以往更加進取，新近黃竹坑站6期DEEP WATER SOUTH首批93伙單位，折實平均呎價已高達29055元，較2025年6月推出的第5期傲晨，大幅高出39%。由於現時黃竹坑站1至5期的細單位供應已幾近沽清，餘下的6期的定價自然較進取。

（作者為世紀21星鑄總經理）



▲港島區過去幾年的供應重點是黃竹坑站上蓋樓盤，今年已賣到最後一期。